

#### 94-0004

Изобретение относится к полупроводниковой технологии и может быть использовано при изготовлении в открытой газотранспортной системе гетероструктур p-InP-pInP/CdS и p-GaAs-pGaAs/CdS для солнечных элементов и фотоэлементов.

Для повышения производительности и качества электрофизических параметров солнечных элементов с помощью заявляемого способа, включающего рост структур p-InP-pInP и p-GaAs-pGaAs в хлоридной газотранспортной системе, химическое травление, расположение структур в реакторе, продувку реактора водородом, нагрев печи, выращивание слоя CdS выполняют после помещения реактора в печь и стабилизации температур, затем выдвигают реактор из печи, причем скорости потока водорода во время выращивания в зоне источника и роста равны, соответственно, 150 см<sup>3</sup>/мин. и 220...240 см<sup>3</sup>/мин., а во время стабилизации температуры и охлаждения - соответственно, 20...30 см<sup>3</sup>/мин. и 1000 см<sup>3</sup>/мин.

Технический результат заключается в сокращении времени стабилизации температуры в реакторе, что обеспечивает сохранение электрофизических параметров слоев и компонента источника, торможение процесса взаимной диффузии компонентов гетероструктуры.

П. формулы: 1